

5月28日(水)

- 強誘電体材料(I)** (座長) 岡村 信吾 (三菱マテリアル) 10:30--12:00
- (28-F-1) A(B⁺,B²⁺)O₃型リラクサー強誘電体のBサイトイオン配列制御
(*阪大産研, **科技団・さきがけ21, ***Twente Univ.) 堀田 育志*, G. W. J Hassink***, 川合 知二*, 田畑 仁**,**
- (28-F-2) (Ag,Li)NbO₃セラミックスにおけるNa⁺, K⁺イオン置換効果
(村田製作所) 竹田 敏和, 高橋 夕香子, 和田 信之, 坂部 行雄
- (28-F-3) PLZT(9/65/35-6/65/35)複合化セラミックスの作成と評価
(日大工) 続 馨, 小林 力
- (28-F-4) Pb(A_{1/2}W_{1/2})O₃-PbZrO₃ (A=Cd, Mn)系固溶体酸化物の強誘電・反強誘電性
(いわき明星大) 横須賀 勝, 三浦 知則
- (28-F-5) エアロゾルデポジション法で作成したPLZT薄膜の電気光学効果
(NEC基礎研, *産総研) 中田 正文, 大橋 啓之, マキシム レベデフ*, 明渡 純*
- (28-F-6) Effects of Niobium Addition on the Relaxor Ferroelectric Properties and Ordering Structures of Lead Iron Tantalates
(KIST) B. -C. Woo and B. -K. Kim
- 薄膜(I)** (座長) 加藤 一実 (産業技術総合研究所) 13:15--14:45
- (28-T-1) 強誘電体ゲートキャパシタのD-E測定
(大阪府立大工) 吉村 武, 藤村 紀文
- (28-T-2) アミン系原料を用いたHfO₂のMOCVD成膜と評価
(東工大物創) 日野 史郎, 中山 誠, 徳光 永輔, 高橋 健治, 舟窪 浩
- (28-T-3) 樹脂フィルム上の高容量薄膜キャパシタ
(NEC機能材料研) 森 透, 渋谷 明信, 山道 新太郎
- (28-T-4) 多重記憶可能な1T/1C型強誘電体メモリの提案
(京大工) 加藤 洋明, 野澤 博
- (28-T-5) Si基板上に作製した中間電極を用いた強誘電体メモリの基本特性
(北陸先端大材料) 家村 伸吾, T. D. Khoa, 村中 一城, 堀田 將
- (28-T-6) CSD法による(Y,Yb)MnO₃/Y₂O₃/Si(MFIS)構造の作製
(産総研) 鈴木 一行, 符 徳勝, 西澤 かおり, 三木 健, 加藤 一実
- 圧電材料(I)** (座長) 鶴見 敬章 (東京工業大学) 15:00--16:15
- (28-P-1) 現象論的熱力学によるPbZrO₃-PbTiO₃系の相図、及び誘電・圧電特性
(防大通信) 山本 孝, 岡 英樹, 沖野 裕文
- (28-P-2) PMN電歪セラミックスとPZT圧電セラミックスにおける非線形性の比較
(防大機能材料) 田代 新二郎, 石井 啓介, 永田 邦裕

- (28-P-3) 表面修飾法により焼結助剤LiBiO₂をコーティングしたPMN-PZT粉末の低温焼結と圧電特性
(湘南工大, *リコー中研) 長谷川 朋之, 林 卓, 富沢 淳, 秋山 善一*
- (28-P-4) ハイブリッド焼結で作製したセラミックスコンポジットの諸特性
(富士セラミックス, *東北大, **本田技研) 高橋 弘文, 塚本 真太郎, 裘 進浩*, 谷 順二*, 鋤柄 宜**
- (28-P-5) Structural and Dielectric Behavior of Sc-substituted Pb(Yb_{1/2}Nb_{1/2})O₃ Ceramics
(KAIST and *Chungang Univ.) J.-H. Kim, H. Kim, K. S. Koh* and W. K. Choo
- 薄膜(II) (座長) 舟窪 浩 (東京工業大学) 16:30--18:00**
- (28-T-7) PZT薄膜の配向制御に及ぼす焼成時の電界印加の効果
(静岡工技セ, *静大工) 中山 洋, 宮原 鐘一, 鈴木 繁*, 鈴木 久男*
- (28-T-8) MOCVD法によるナノサイズPbTiO₃自己集合島の作製と評価
(姫路工大工, 富士通研究所*) 野々村 哉, 藤沢 浩訓, 清水 勝, 丹生 博彦, 本田 耕一郎*
- (28-T-9) スパッタ法により作製したPZT薄膜キャパシタにおける特性劣化および結晶欠陥の熱刺激電流測定
(奈良先端大物質) 西田 貴司, 松岡 正浩, 岡村 総一郎, 塩崎 忠
- (28-T-10) Effects of Seeding Layer and PZT Thickness on Reliability of FRAM Device with 0.25um D/R
(Samsung Electronics Co.) K. S. Park, K. M. Lee, S. D. Nam, M. S. LEE, S. H. Joo, S. L. Cho, Y. H. Son, S. H. Choi, J. C. Shin, H. J. Kim, Y. J. Jung, M. S. Choi, J. E. Heo, H. G. An, S. O. Park, U. I. Chung, and J. T. Moon
- (28-T-11) Dielectric and Electromechanical Properties of Highly Textured Pb(Zr,Ti)O₃ Thin Films for Piezo-MEMS Devices
(INOSTEK Inc., *Korea Elec. Tech. Inst., **Seoul National Univ. and ***Han Yang Univ.) S.-H. Kim, J.-S. Yang, C. Y. Koo, J.-H. Yeom, J.-S. Park*, E. Yoon**, S.-G. Kang*** and J. Ha
- (28-T-12) Characterizations of Sol-Gel Multi-Coated Thick PZT Films on Platinized Silicon Substrates for Micro Devices Applications
(*Korea Elec. Tech. Inst., **Inostek Inc. and ***Han Yang Univ.) J.-S. Park*, ***, S.-H. Kim**, H.-D. Park*, J. Ha** and S.-G. Kang***

5月29日(木)

- 薄膜(III) (座長) 清水 勝 (姫路工業大学) 9:00--10:15**
- (29-T-13) MOCVD法によりSi基板上に作製したPb(Zr,Ti)O₃厚膜の電気特性の組成依存性
(東工大物創, *産総研) 横山 信太郎, 本田 佳久, 森岡 仁, 浅野 剛司, 飯島 高志*, 松田 弘文*, 舟窪 浩
- (29-T-14) Spray噴霧法を用いたPZTの成膜とその特性
(産総研) 一木 正聡, 張麓, 楊振, 池原 毅, 前田 龍太郎
- (29-T-15) Sol-Gel/PLD複合プロセスによるPZT薄膜の作製と評価
(東北大工, *産総研) 王 占杰, L. J. Yan, 粉川 博之, 前田 龍太郎*
- (29-T-16) エアゾールデポジション法によるPZT厚膜の低温形成
-高速原子ビーム照射による電気特性の改善-
(産総研) 明渡 純, マキシム レベデフ

- (29-T-17) Comparison of Lead Source Material on the Microstructure and Ferroelectric Properties of Sputter Deposited PZT Films Using Lead and Lead Oxide for Compensation
(Feng-Chia Univ.) W. L. Chang and J. L. He

薄膜(IV) (座長) 田畑 仁 (大阪大学) 10:30--12:00

- (29-T-18) 等方加圧アニール法により結晶化した $0.24\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3 \cdot 0.384\text{PbZrO}_3 \cdot 0.376\text{PbTiO}_3$ 薄膜の諸特性
(姫路工大工) 小舟 正文, 児島 慎一, 嶺重 温, 矢澤 哲夫
- (29-T-19) 強誘電体 $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ 薄膜の電気機械特性の温度依存性
(湘南工大, *Inostek, **早大理工) 真岩 宏司, S.-H. Kim*, 一ノ瀬 昇**
- (29-T-20) PZT薄膜の強誘電性に及ぼす電極構造の影響
(八戸工大工) 野坂 隆, 馬場 明, 増田 陽一郎
- (29-T-21) Effect of Top Electrode in Dielectric Properties on Relaxor $\text{Pb}(\text{Sc}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3$ Thin Film Capacitors
(KAIST and *EPFL) B. J. Kuh, J. -H. Kim, W. K. Choo, K. Brinkman*, D. Damjanovic* and N. Setter*
- (29-T-22) Thickness Effect on the Pyroelectric Properties of Chemical Solution Derived PZT Thin Films for the PIR Sensor Devices
(INOSTEK Inc., *Seoul National Univ., **Korea Elec. Tech. Inst., ***KIST and ****Han Yang Univ.) J. -S. Yang, S. -H. Kim, D. -Y. Park, E. Yoon*, J. -S. Park**, T. -S. Kim***, S. -G. Kang**** and J. Ha
- (29-T-23) A Contribution of Mechanical Stresses into Self-Polarization in Thin PZT Films
(A.F.Ioffe Physico-Technical Institute Russian Academy of Sciences, *St. -Petersburg State Electrotechnical Univ.) I.P. Pronin, E.Yu. Kaptelov, A.V. Goltsev and V.P. Afanasjev*

強誘電体材料(II) (座長) 坂部 行雄 (村田製作所) 13:15--14:45

- (29-F-7) 化学溶液法による $(\text{Bi}, \text{Nd})_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ 強誘電体薄膜のUVプロセッシング
(湘南工大, 名大理工総研*, 名大院工**) 林 卓, 飯澤 直也, 戸川 大地, 山田 美緒**, 坂本 渉*, 菊田 浩一**, 平野 真一**
- (29-F-8) 低温成長 YMnO_3 薄膜の構造解析とその誘電特性
(大阪府立大工) 坂田 浩憲, 伊藤 大輔, 吉村 武, 藤村 紀文, 伊藤 太一朗
- (29-F-9) MOCVDによるPZT薄膜形成用新規Zr材料の評価
(三菱マテリアル) 岡村 信吾, 高山 佳典, 曾山 信幸, 小木 勝実
- (29-F-10) 積層セラミックコンデンサの内部応力に関する研究
(TDK, *東理大理工) 中野 幸恵, 野村 武史, 竹中 正*
- (29-F-11) B特性Ni-MLCCの応力・熱・電場応答性
(太陽誘電) 斉藤 賢二, 茶園 広一, 岸 弘志
- (29-F-12) TSFZ法によるニオブ酸カリウム結晶の評価
(長野県精密工業試験場, *信州大工) 工藤 賢一, 垣内 健児, 水谷 康治*, 深海 龍夫*

薄膜(V) (座長) 塩崎 忠 (奈良先端科学技術大学院大学) 15:00--16:00

- (29-T-24) MOCVD法により作製された $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ 薄膜のキャリアーガスの効果
(東理大理) 中村 誠, 樋口 透, 塚本 桓世
- (29-T-25) 原料交互供給によるチタン酸ピスマス薄膜の作成と評価
(芝浦工大, *八戸工大) 山口 正樹, 増田 陽一郎*
- (29-T-26) $\text{Bi}_{4-x}\text{Pr}_x\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ 多結晶薄膜の配向特性と強誘電・圧電特性
(産総研) 松田 弘文, 伊藤 佐千子, 飯島 高志
- (29-T-27) 化学溶液法により作製した $(\text{Ca},\text{Sr})\text{Bi}_4\text{Ti}_4\text{O}_{15}$ 薄膜の電気的特性
(上智大理工, *産総研, **東工大物創) 内田 寛, 桜井 恵子, 岡田 勲, 松田 弘文*, 飯島 高志*, 小島隆志**, 渡邊 隆之**, 舟窪 浩**
- 招待講演 (座長) 石橋 善弘 (愛知淑徳大学) 16:15--16:45
(29-I-1) (招待講演)未定 (未定) 未定
- 特別講演 (座長) 塩崎 忠 (奈良先端科学技術大学院大学) 16:45--17:45
(29-S-1) 「ピスマス系複酸化物強誘電体と取り組んで40年」 - 荒野の時代を顧みて今後の動向を探る -
(東理大) 坂田 好一郎

5月30日(金) パラレルセッション 202号室

- 圧電材料(II) (座長) 山本 孝 (防衛大学校) 9:00--10:15
- (30-P-6) 巨大電気機械結合係数 k_{31} モードをもつ $\text{Pb}[(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_{0.91}\text{Ti}_{0.09}]\text{O}_3$ 単結晶での結晶配向依存およびバイポーラハルス分極特性
(静岡理工科大) 小川 敏夫, 沼本 芳樹
- (30-P-7) モルフォトロピック相境界近傍での $\text{Pb}(\text{In}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ - PbTiO_3 単結晶のドメイン構造と誘電特性への電界効果
(岐阜大, *東芝, **名工大, ***愛知淑徳大) 安田 直彦, 阪口 正広, 大和 英弘, 山下 洋八*, 岩田 真**, 石橋 善弘***
- (30-P-8) ブリッジマン法によるインジウムニオブ酸鉛(スカンジウムニオブ酸鉛)-マグネシウムニオブ酸鉛-チタン酸鉛3成分系圧電単結晶の育成
(東芝研究開発センタ, *早大理工) 細野 靖晴, 山下 洋八, 坂本 英也*, 一ノ瀬 昇*
- (30-P-9) TSSG法によるインジウムニオブ酸鉛 マグネシウムニオブ酸鉛 チタン酸鉛3成分系圧電単結晶の育成
(富山県大) 中本 真紀, 住吉 洋一, 唐木 智明, 安達 正利
- (30-P-10) $\text{LaCa}_4\text{O}(\text{BO}_3)_3$ 結晶の作製と圧電特性
(奈良先端大物質, *堺化学工業) 武田 博明, 迫 秀樹, 西田 貴司, 岡村 総一郎, 中尾 日六士*, 西田 雅宏*, 式田 尚志*, 塩崎 忠
- 圧電材料(III) (座長) 山下 洋八 (東芝 研究開発センター) 10:30--12:00
- (30-P-11) $(\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2})\text{TiO}_3$ $(\text{Bi}_{1/2}\text{K}_{1/2})\text{TiO}_3$ BaTiO_3 三成分系非鉛セラミックスの圧電特性
(東理大理工) 永田肇, 吉田正樹, 牧内洋一, 竹中正

- (30-P-12) 放電プラズマ焼結法による強誘電性 NaNbO_3 セラミックスの作製
(龍谷大理工) 和田 隆博, 辻 健二, 齊藤 武尚, 松尾 嘉浩
- (30-P-13) LaFeO_3 を微量添加した KNbO_3 セラミックスの強誘電および圧電特性
(名工大材料工) 柿本 健一, 増田 いづみ, 大里 齊
- (30-P-14) $\text{LnBi}_2\text{TiNbO}_9$ 系セラミックスの作製・評価
(東光, 足工大*, 東理大**) 菅谷 豊, 荘司 和男*, 坂田 好一郎**
- (30-P-15) 高い機械的品質係数 Q_m を持つ $\text{Bi}_{3-x}\text{M}_x\text{TiTaO}_9$ (M=La, Nd)セラミックス
(東理大理工, *東工大物質) 鈴木 宗泰, 大原 仁, 永田 肇, 舟窪 浩*, 竹中 正
- (30-P-16) $\text{SrBi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$ 系セラミックスの弾性異常
(村田製作所, *EPFL) 澤田 拓也, 安藤 陽, 坂部 行雄, D. Damjanovic*, N. Setter*

マイクロ波材料 (座長) 田村 博 (村田製作所) 13:15--14:45

- (30-M-1) V_2O_5 添加による $\text{Mg}_4\text{Nb}_2\text{O}_9$ の低温焼成化とマイクロ波誘電特性
(名城大理工, *名工大物質工) 菅 章紀, 小川 宏隆, 吉田 篤史, 横井 敦史, 大里 齊*
- (30-M-2) LnBO_3 系酸化物(Ln=La, Nd, Sm, Dy, Ho, Y)の合成とマイクロ波誘電特性
(住友金属) 高田 隆裕, 山元 寿文, 景山 恵介
- (30-M-3) RFインピーダンス・アナライザによる BaTiO_3 系セラミックスの誘電スペクトル測定
(東工大理工, 産総研*) 掛本 博文, 李 建永, S.-M. Nam*, 和田 智志, 鶴見 敬章
- (30-M-4) $\text{Ba}_4\text{Sm}_{9.33}\text{Ti}_{18}\text{O}_{54}$ セラミックスの粒子配向制御とマイクロ波誘電特性
(名工大物質工) 和田 賢介, 柿本 健一, 大里 齊
- (30-M-5) Low Temperature Sintering and Microwave Dielectric Properties of BiNbO_4 - ZnNb_2O_6 Ceramics with Addition of $\text{CuO-V}_2\text{O}_5$ Compounds
(Yonsei Univ. and *Kyonggi Univ.) H. R. Lee, K. H. Yoon and E. S. Kim*
- (30-M-6) Microwave Dielectric Properties of CaTiO_3 and MgTiO_3 Thin Films
(Yonsei Univ. and *Kyonggi Univ.) B. D. Lee, K. H. Yoon and E. S. Kim*

薄膜(VI) (座長) 徳光 永輔 (東京工業大学) 15:00--16:00

- (30-T-28) AFMによる $\text{CaBi}_4\text{Ti}_4\text{O}_{15}$ 強誘電体薄膜の圧電特性の評価
(産総研) 符 徳勝, 鈴木 一行, 加藤 一実
- (30-T-29) 分極反転のリアルタイム計測
(東北大通研) 森田 剛, 長 康雄
- (30-T-30) Influence of Trapped Injected Charge on the Capacitance and Leakage Characteristics of $(\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x})\text{Ti}_{1+y}\text{O}_{3+z}$ Thin Film Capacitors
(Fujitsu Laboratories) J D. Baniecki, T. Shioga, K. Kurihara
- (30-T-31) Imprint After Fatigue Characteristics of BLT-based FeRAMs
(Hynix Semiconductor Inc.) K. H. Noh, S.-S. Lee, H. J. Jeong, J. H. Son, J. G. Kim, J. Y. Seong, S. H. Oh, Y. H. Yang, S.-K. Hong and Y.-J. Park

薄膜(VII) (座長) 藤村 紀文 (大阪府立大学) 16:15--17:15

- (30-T-32) SrBi₂Ta₂O₉薄膜の初期成長観察
(阪大超伝導セ) 川山 巖, 小谷 研太, 斗内 政吉
- (30-T-33) 自然超格子構造を有するBi₄Ti₃O₁₂-SrBi₄Ti₄O₁₅ (m = 3-4)薄膜の作製と評価
(阪大基礎工) 渋谷 明, 野田 実, 奥山 雅則
- (30-T-34) 櫛型電極によるSrBi₂Ta₂O₉薄膜の誘電特性の温度変化
(阪大超フォト研) 小谷 研太, 川山 巖, 斗内 政吉
- (30-T-35) Preparation and Ferroelectric Characteristics of Barium-ion Doped Strontium Bismuth Tantalate Thin Films
(Natl Taiwan Univ.) C. -H. Lu, D. -P. Chang and W. -J. Hwang

5月30日(金) パラレルセッション 201号室

- 基礎(I)** (座長) 上江洲 由晃 (早稲田大学) 9:00--10:15
- (30-B-1) 接触共振圧電応答顕微鏡によるPb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃単結晶のドメイン観察
(防大通信) 沖野 裕丈, 山本 孝
- (30-B-2) AFM によるPZN-PTのドメインウォール構造
(名工大工, *岐阜大工, **愛知淑徳大) 岩田 真, 鬘谷 浩平, 前田 雅輝, 鈴木 昱雄, 安田 直彦*, 石橋 善弘**
- (30-B-3) 非線形誘電率顕微鏡を用いた超高密度強誘電体記録再生
(東北大通研, *パイオニア総研) 平永 良臣, 長 康雄, 藤本 健二郎, 我妻 康夫, 尾上 篤*
- (30-B-4) Electrostatic Model for the Dielectric Permittivity of Ferroelectric Films with 90° Domain Structures
(Aichi Shukutoku Univ. and * Osaka Univ.) Y. Ishibashi, D. Ricinchi* and M. Okuyama*
- (30-B-5) nmオーダーチタン酸バリウム微粒子の合成とその誘電特性評価
(東工大理工) 和田 智志, 安野 弘明, 保科 拓也, S.-M. Nam, 掛本 博文, 鶴見 敬章
- 基礎(II)** (座長) 小野寺 彰 (北海道大学大学院) 10:30--12:00
- (30-B-6) What a Structure Model is Suitable for Lithium Niobate Family Ferroelectrics?
(AML/NIMS) D. Xue and K. Kitamura
- (30-B-7) 軟X線分光によるBi_{4-x}La_xTi₃O₁₂, Bi₄Zr_xTi_{3-x}O₁₂の電子構造
(東理大理, *東大生研) 樋口 透, 森内 祥行, 塚本 桓世, 野口 祐二*, 宮山 勝*, 辛
- (30-B-8) (Bi, M)₄Ti₃O₁₂の第一原理計算による電子構造の解明
(湘南工大) 湯藤 幸男, 杉原 淳, 磯邊 孝昌
- (30-B-9) 量子常誘電体SrTiO₃の¹⁶O ¹⁸O同位元素効果の理論
(岐阜大工) 松下 栄子, 奥村 振一郎
- (30-B-10) テラヘルツ時間領域分光法によるLiTaO₃の誘電的性質の研究
(筑波大学, *信州大学) 小島 誠治, 北原 英明*, 西澤 誠治*, 武田 三男*

- (30-B-11) Raman and OH⁻ Absorption Spectra of Zn-doped Lithium Niobate Crystals
(Natl. Taiwan Normal Univ., *Natl. Central Univ. and **Academia Sinica, ***Natl. Taiwan Univ.) M-L Sun, C-T Chia, M-L Hu*, J. Y. Chang*, W-S Tse**, Z. P. Yang*** and H. H. Cheng***

基礎・液晶 (座長) 小島 誠治 (筑波大学) 13:15--14:45

- (30-E-1) 層状ペロブスカイトSBTの中間相の結晶構造
(北大理, *北海学園大工) 小野寺 彰, 吉尾 圭司, 山下 晴康*
- (30-E-2) パナジウムドーブBi₄Ti₃O₁₂単結晶の導電特性
(東大生研) 高橋 尚武, 曾我 雅之, 野口 祐二, 宮山 勝
- (30-E-3) 熱輻射熱量法による強誘電体Ba (Ti, Zr) O₃セラミックスの熱物性測定
(防大通信) 森本 康介, 澤井 真也, 久野 九万雄, 山本 孝
- (30-E-4) 圧電性高分子ポリ乳酸膜の新規な作製法とその構造・物性
(山形大工, *三井化学, **小林理研) 田實 佳郎, 助川 誠*, 菊地 美幸, 須藤 信行, 工藤 益男, 増子 徹, 伊達 宗宏**, 深田 栄一
- (30-E-5) 強誘電性液晶自己保持膜の電界誘起振動
(阪大工) 中野 和行, 尾崎 雅則, 吉野 勝美
- (30-E-6) 高分子安定化反強誘電性液晶
(*科学技術振興事業団, **産総研) 古江 広和*, 横山 浩**,**

圧電材料(IV) (座長) 竹中 正 (東京理科大学) 15:00--16:00

- (30-P-17) スクリン印刷法によるシリコン基板上へのBa(Ti,Zr)O₃厚膜の作製
(富山県工技セ, *富山県大工) 二口 友昭, 坂井 雄一, 藤田 直*, 安達 正利*
- (30-P-18) エアロゾルデポジション法で形成したPZT厚膜による高速マイクロ光スキャナーの製作
(プラザー工業, *産総研) 浅井 伸明, 明渡 純*, マキシム レベデフ*, 山田 祥治
- (30-P-19) 液体吸引機能を有する圧電吐出ヘッドの検討
(*オリンパス光学, **山形大工) 高橋 誠也*,**, 富川 義朗**
- (30-P-20) 小型簡易圧電測定器の試作
(早大理工) 福永 守, 上江洲 由晃

圧電応用(I) (座長) 高橋 貞行 (早稲田大学) 16:15--17:15

- (30-A-1) 高次モード利用圧電トランスの積層化の検討
(山形大工) 広瀬 精二, 遠藤 勉
- (30-A-2) 圧電・角・加速度センサ
(山形大工, *マイクロストーン) 富川 義朗, 伊藤 昌弘, 岡田 恵也*
- (30-A-3) Fabrication and Characteristics of PDA CCFL Driving Circuits for Piezoelectric Transformer Using PNW-PMN-PZT Ceramics
(Semyung University, *Daewon Science College and **Dongseoul College) L. Hwang, E. Jang, W. Nam, J. Yoo, D. Oh, M. Cho*, I. Ahn* and J. Hong**

(30-A-4) The Characteristics of Windmill Type Ultrasonic Motor with Modified Endcap
(Changwon University and *Pennsylvania State Univ.) J. H. Lee, T. G. Park, H. H. Chong and K. Uchino*

チュートリアル (座長) 奥山 雅則 (大阪大学大学院) 17:30--18:30
(30-TU-1) マイクロ波誘電体材料の基礎と応用
(村田製作所) 田村 博

5月31日(土)

圧電応用(II) (座長) 富川 義朗 (山形大学) 9:00--10:15
(31-A-5) 漏洩ラム波液体遅延線発振器を用いた極微小変位の測定
(防大) 藤田 剛, 戸田 耕司

(31-A-6) ランガサイトを基板材料とした高温用ワイヤレスSAW温度センサー
(三菱マテリアル) 王 守奇, 原田 次郎, 宇田 聡

(31-A-7) $K_2O-Nb_2O_5$ 系の新強誘電体相: $K_5Nb_9O_{25}$
(山口大工, *島根大教育) 小松 隆一, 錦織 和子, 桶谷 忠正, 池田 攻, 秋重 幸邦*

(31-A-8) Fabrication of Cantilever and Bridge Type Piezoelectric Micro-Transducer for Mass Detecting Device
(Sung Kyun Kwan Univ. and *Korea Elec. Tech. Inst.) S. Shin, S. Song, J. Kim, D. Jung, H. Park*, J. Park* and J. Lee

(31-A-9) Electrical Characteristics of 3rd Overtone Mode Energy-Trapped High Frequency Ceramic Filter Using $PbTiO_3$ System Ceramics
(Semyung Univ., *Kyungmoon College, **Kyungpook National Univ., ***Samsung Electro-Mechanics Co., ****Korea electric power co. and *****Chungju Univ.) D. Oh, J. Yoo, C. Park, H. Yoon*, S. Lee**, J. Kim***, Y. Jeong****, S. Ryu***** and S. Lee*****

薄膜(VIII) (座長) 高須 秀視 (ローム) 10:30--12:00
(31-T-36) ミリ波照射が $SrTiO_3$ 薄膜の結晶化に与える影響
(松下電産) 大塚 隆, 森本 廉, 森田 清之

(31-T-37) コンピナトリアルPLD法による $SnTiO_3$ 薄膜の作製
(富士電機総研, 東工大応セラ研*, 物質・材料研究機構**, 東北大***) 小西 義則, 大沢 通夫, 米澤 喜幸, 寺尾 豊, 脇坂 寿幸*, 知京 豊裕**, 篠田 克巳***, 久保 百司***, 宮本 明***, 鯉沼 秀臣**, **

(31-T-38) ECR-PLD法による $KNbO_3$ 薄膜の成長
(東北大工) 新井 孝, 伊藤 重夫, 石川 一夫, 中村 信良

(31-T-39) SPS法による高密度セラミックターゲットを用いたPLD法による $KNbO_3$ 薄膜の形成
(龍谷大理工, 松下電器先端研*, 京大工**) 齊藤 武尚, 和田 隆博, 足立 秀明*, 神野 伊策**

(31-T-40) 化学溶液法による希土類元素置換 $BaNb_2O_6$ 薄膜の作製と評価
(名大理工科学総合研究センター, *名大工) 坂本 涉, 水野 将成*, 山口 十志明*, 菊田 浩一*, 平野 真一*

(31-T-41)

Comparison of Strain Development between BaTiO₃/SrTiO₃ Artificial Lattice and Single Oxide Layer and its Effect on the Dielectric Properties

(Sung Kyun Kwan Univ.) J. Kim, L. Kim, Y. S. Kim, D. Jung and J. Lee